

日程表 (分科別 I)

大分類分科名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
特別シンポジウム								
『超スマート社会へ向けた応用物理』 ～第5期科学技術基本計画への期待と課題～		C41 13:00 ~ 17:45						
国際フェロー特別講演								
2016年度国際フェロー特別講演 Alexei Gruverman氏		A23 13:30 ~ 14:00						
2016年度国際フェロー特別講演 David Attwood氏		C31 15:30 ~ 16:00						
シンポジウム								
S.1 学習意欲向上のための授業改善 ～能動的学習に向けた実践事例について～		B10 13:45 ~ 16:45						
S.24 ナノフォトニクスと熱の融合		C302 13:45 ~ 18:00						
S.7 STMノーベル賞&AFM発明30周年記念シンポジウム ～プローブ顕微鏡のこれまでとこれから～		A31 13:15 ~ 17:30						
S.8 薄膜・表面分野で活躍する女性研究者		A32 13:15 ~ 18:00						
S.9 酸化物エレクトロニクスの未来展望を描く		A22 13:15 ~ 18:15						
S.13 弱磁性物質への磁場効果を利用した材料プロセス		A34 13:15 ~ 16:30						
S.15 ナノバイオテクノロジーとバイオセンシングに関するジョイントシンポジウム		B1 13:15 ~ 18:00		P23 16:00 ~ 18:00				
S.25 ナノ界面現象と評価技術の現状と課題		B7 13:15 ~ 18:15						
S.26 多元系化合物の機能性評価技術の新展開 ー多元系デバイス開発への知見提供ー		B9 13:30 ~ 18:00						
S.19 古くて新しい点欠陥 ～材料を越えた視点から見えてくるもの～		B8 13:45 ~ 18:00						
S.3 放射線医療現場における変動型検出器による計測手法の最近の進展				B9 13:45 ~ 17:30				
S.4 フォトニクス分科会シンポジウム「フォトニクスの未来を担う研究者」				A41 13:15 ~ 18:00				
S.5 量子技術へ向けたハイブリッドアプローチ				B8 13:45 ~ 18:00				
S.10 DLC膜の国際標準化 ー標準化を支える先端評価技術と世界展開を睨んだ産業応用ー				A23 13:30 ~ 17:30				
大分類分科名								
中分類分科名								
S.11 プロセスプラズマ診断の最前線～大気圧、気液混合プラズマの理解と制御にむけて～				A22 13:30 ~ 17:45				
S.17 IV族半導体薄膜の結晶化と欠陥制御				B7 12:30 ~ 19:15				
S.18 AI/ディープラーニング時代に向けたIoT/IoEデバイス技術				B1 13:45 ~ 16:15				
S.20 窒化物半導体の最前線 ー欠陥のない結晶・デバイスを狙ってー				A21 13:00 ~ 19:00				
S.22 太陽電池モジュール信頼性の現状と今後の展開				A24 13:00 ~ 18:00				
S.23 機能性原子薄膜材料の新展開 ー成膜技術 ー				A33 13:15 ~ 18:15				
S.2 太陽光水素製造触媒の材料と物理					A24 13:00 ~ 17:30			
S.6 フォトニックインテリジェンスの様相					A32 13:15 ~ 17:00			
S.14 応用に向けた新規スピントロニクス現象の物理					C41 13:15 ~ 17:00			
S.16 バイオと共生する電子デバイスを目指して					B11 13:45 ~ 19:00			
S.21 窒化物半導体特異構造の科学 ～新機能の発現と理解～					A21 13:15 ~ 18:15			
S.12 熱電変換の現在と未来: ZTはどこまで上がるのか?							A34 08:45 ~ 12:15	
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域				P11 16:00 ~ 18:00				
1.2 教育			P1 09:30 ~ 11:30					
1.3 新技術・複合新領域			D63 09:15 ~ 12:00	P12 16:00 ~ 18:00				
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境			A36 09:00 ~ 12:45	P13 16:00 ~ 18:00				
1.5 計測技術・計測標準					P1 13:30 ~ 15:30		C42 # 09:00 ~ 12:15	
1.6 超音波	D63 10:00 ~ 12:00	P1 13:30 ~ 15:30						
		D63 # 16:00 ~ 18:00						

講演分科日程表の読み方
(例)

2016年9月13日(火)	
午前	午後
ポスターセッションのみ	
	P2 13:30 ~ 15:30
場所の記号 (C31会場)	
	C31 13:45 ~ 17:00
講演時間	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
<建物略称>
A: 朱鷺メッセ
B: 朱鷺メッセ展示ホール内
C: ホテル日航
D: 万代島ビルディング会議室
P: 朱鷺メッセ展示ホール

: 分科内招待講演あり
: 海外研究者招待講演あり
* : 論文賞受賞記念講演あり

日程表（分科別Ⅱ）

大分類分科名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎			D61 09:00 ~ 10:30		A37 09:00 ~ 11:45	A37 # 13:15 ~ 15:15		
2.2 検出器開発		B12 13:00 ~ 18:00				P14 16:00 ~ 18:00		
2.3 放射線応用・発生装置・新技術							A37 09:00 ~ 12:15	
3 光・フォトニクス ※コードシェアセッションあり 3.5・3.14、3.6・3.8、3.14・3.15、3.11・13.7 (表の末尾参照)								
3.1 光学基礎・光学新領域			B9 09:00 ~ 12:30	P1 13:30 ~ 15:30				
3.2 材料・機器光学						C42 13:45 ~ 16:45	P1 09:30 ~ 11:30	
3.3 情報フォトニクス・画像工学					C42 # 09:00 ~ 12:15		P2 09:30 ~ 11:30	C42 13:45 ~ 16:45
3.4 生体・医用光学				C42 13:15 ~ 19:00	P1 09:30 ~ 11:30			
3.5 レーザー装置・材料	B3 09:00 ~ 12:15	B3 13:45 ~ 16:15		P2 13:30 ~ 15:30				
3.6 超高速・高強度レーザー			C32 09:15 ~ 12:15	C32 13:45 ~ 17:30	P2 09:30 ~ 11:30			
3.7 レーザープロセッシング	C31 # 09:30 ~ 12:00		C31 09:30 ~ 12:15	C31 13:45 ~ 17:30	P3 09:30 ~ 11:30			
3.8 光計測技術・機器			P2 09:30 ~ 11:30		C32 09:00 ~ 12:15		C32 09:00 ~ 12:15	C32 13:45 ~ 16:00
3.9 テラヘルツ全般			B2 09:00 ~ 12:00	B2 13:15 ~ 18:15			B2 09:00 ~ 12:30	P1 13:30 ~ 15:30
3.10 光子物理・技術		B2 13:45 ~ 17:00			P4 09:30 ~ 11:30			
3.11 フォトニック構造・現象				P14 16:00 ~ 18:00		B4 15:45 ~ 19:00	B4 # 09:00 ~ 12:45	
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学					P5 09:30 ~ 11:30	B12 13:45 ~ 19:00	B12 09:00 ~ 12:15	B12 13:45 ~ 16:30
3.13 半導体光デバイス					P6 09:30 ~ 11:30		A35 09:00 ~ 11:45	A35 13:15 ~ 15:30
3.14 光制御デバイス・光ファイバー				B3 13:45 ~ 16:30	P7 09:30 ~ 11:30			
3.15 シリコンフォトニクス			B4 10:30 ~ 11:45	B4 13:45 ~ 18:00	P8 09:30 ~ 11:30			
4 JSAP-OSA Joint Symposia 2016								
4.1 Plasmonics	C302 09:00 ~ 12:00		C302 09:00 ~ 12:15	C302 15:00 ~ 18:00				
4.2 Bio-and Medical Photonics		P6 16:00 ~ 18:00			C31 09:15 ~ 12:15	C31 13:45 ~ 16:45		
4.3 Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications				C302 13:45 ~ 14:45				
				C301 15:15 ~ 19:00				
4.4 Opto-electronics		P6 16:00 ~ 18:00					C301 09:00 ~ 12:00	C301 13:30 ~ 17:15
4.5 Information Photonics	C301 09:00 ~ 12:15		C301 09:00 ~ 12:15					
4.6 Nanocarbon and 2D Materials		A37 13:15 ~ 17:45						
		P6 16:00 ~ 18:00						
4.7 Terahertz Photonics						C301 13:15 ~ 17:30		
4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering		C301 13:45 ~ 18:00						
		P6 16:00 ~ 18:00						
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜	A23 09:00 ~ 11:45	A23 13:15 ~ 16:45	A23 09:00 ~ 11:45	P3 13:30 ~ 15:30				
6.2 カーボン系薄膜		A26 * 13:15 ~ 18:00	A26 09:00 ~ 11:45	A26 13:15 ~ 17:45	A26 09:00 ~ 12:00	P2 13:30 ~ 15:30		
6.3 酸化物エレクトロニクス	A31 09:00 ~ 11:45		A31 09:30 ~ 12:00	A31 13:30 ~ 17:45	A31 09:00 ~ 12:15	P3 13:30 ~ 15:30	A31 09:30 ~ 11:45	
6.4 薄膜新材料	D62 # 09:00 ~ 12:15	D62 # 13:45 ~ 17:30	A37 09:00 ~ 11:45	A37 13:15 ~ 17:45				
		P7 16:00 ~ 18:00						
6.5 表面物理・真空						P15 16:00 ~ 18:00	B3 09:00 ~ 10:30	B3 13:45 ~ 16:15
6.6 プローブ顕微鏡			A32 09:30 ~ 11:15	A32 13:15 ~ 17:30	A32 09:30 ~ 11:15	P4 13:30 ~ 15:30		

日程表（分科別Ⅲ）

大分類分科名 中分類分科名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術		P2 13:30 ~ 15:30						
		C31 13:45 ~ 17:00						
7.2 電子ビーム応用				P15 16:00 ~ 18:00		B5 # 13:15 ~ 18:45		
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	D61 09:00 ~ 12:15			P16 16:00 ~ 18:00				
7.4 量子ビーム界面構造計測	A25 # 09:00 ~ 12:30	P3 13:30 ~ 15:30						
7.5 イオンビーム一般		P4 13:30 ~ 15:30		B6 # 13:45 ~ 17:15				
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術				P17 16:00 ~ 18:00				
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・制御					B7 09:00 ~ 12:30			P2 13:30 ~ 15:30
8.2 プラズマ診断・計測	B7 09:00 ~ 11:45					P5 13:30 ~ 15:30		
8.3 プラズマ成膜・表面処理						P6 13:30 ~ 15:30		B7 13:15 ~ 16:45
8.4 プラズマエッチング	B9 09:00 ~ 11:45					P7 13:30 ~ 15:30		
8.5 プラズマナノテクノロジー							B7 09:00 ~ 11:30	P3 13:30 ~ 15:30
8.6 プラズマライフサイエンス						B7 13:45 ~ 18:30		P4 13:30 ~ 15:30
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野						P8 13:30 ~ 15:30	B13 09:00 ~ 11:45	
8.8 Plasma Electronics English Session		A41 14:45 ~ 16:15						P5 13:30 ~ 15:30
8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		A41 # # 13:00 ~ 14:30	A22 # 11:00 ~ 11:30					
8.10 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			A22 09:45 ~ 10:45					
9 応用物性 ※コードシェアセッションあり 9.4・16.2 (表の末尾参照)								
9.1 誘電材料・誘電体					D62 09:30 ~ 11:45	P16 16:00 ~ 18:00		
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			D62 09:00 ~ 12:15	D62 13:30 ~ 19:00	P9 09:30 ~ 11:30			
9.3 ナノエレクトロニクス	C42 09:45 ~ 12:00	C42 13:30 ~ 16:00				P17 16:00 ~ 18:00		
9.4 熱電変換					A35 # 09:00 ~ 12:00	A35 13:30 ~ 18:00		
9.5 新機能材料・新物性		A25 13:45 ~ 17:00	P3 09:30 ~ 11:30					
10 スピントロニクス・マグネティクス ※コードシェアセッションあり 10.1・10.2・10.3・10.4 (表の末尾参照)								
10.1 新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	A22 09:00 ~ 12:00							
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術			C41 09:00 ~ 10:30			C41 10:45 ~ 12:15		C41 * 13:15 ~ 14:45
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		P8 16:00 ~ 18:00				C41 09:00 ~ 10:30		
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス			C41 10:45 ~ 12:15	C41 13:15 ~ 19:00				
10.5 磁場応用	A34 10:45 ~ 12:15							
11 超伝導								
11.1 基礎物性					D63 09:15 ~ 11:15	D63 12:45 ~ 17:45		
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長					D63 # 13:15 ~ 16:00			
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用				P4 09:30 ~ 11:30	D63 # 16:00 ~ 19:00			
11.4 アナログ応用および関連技術					D61 13:15 ~ 19:00	D61 09:00 ~ 11:45		
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						D61 13:15 ~ 17:00		
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御					B5 09:00 ~ 12:15		B5 09:00 ~ 12:30	P6 13:30 ~ 15:30
12.2 評価・基礎物性		B5 13:45 ~ 17:45	B5 09:00 ~ 12:15	B5 13:45 ~ 17:00		P9 13:30 ~ 15:30		
12.3 機能材料・萌芽的デバイス			P5 09:30 ~ 11:30	B13 # 13:45 ~ 18:00	B13 * 09:00 ~ 12:00	B13 13:45 ~ 15:30		
12.4 有機EL・トランジスタ	B11 09:00 ~ 11:45	B11 13:15 ~ 17:30	B11 09:00 ~ 11:30	B11 13:15 ~ 17:00	B11 09:00 ~ 12:00			P7 13:30 ~ 15:30
12.5 有機太陽電池		B4 # 13:15 ~ 15:30	A41 09:00 ~ 12:00		A41 09:00 ~ 12:15	A41 13:15 ~ 18:00	A41 09:00 ~ 12:00	A41 13:15 ~ 15:30
		P9 16:00 ~ 18:00						
12.6 ナノバイオテクノロジー	B10 09:00 ~ 12:15		B10 09:00 ~ 12:15	B10 13:45 ~ 15:45				
				P18 16:00 ~ 18:00				
12.7 医用工学・バイオチップ	B8 09:00 ~ 12:15		B8 09:00 ~ 12:15	P19 16:00 ~ 18:00	B8 09:00 ~ 12:15		B8 09:00 ~ 12:00	

日程表（分科別Ⅳ）

大分類分科名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体 ※コードシェアセッションあり 3.11・13.7 (表の末尾参照)								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション				P4 13:30 ~ 15:30	B2 10:00 ~ 12:15	B2 13:45 ~ 17:30		
13.2 探索的材料物性・基礎物性					B3 09:00 ~ 11:15	B3 13:45 ~ 16:45	P3 09:30 ~ 11:30	
13.3 絶縁膜技術					B9 10:15 ~ 11:45	B9 13:15 ~ 17:45	P4 09:30 ~ 11:30	
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術				P5 13:30 ~ 15:30	B10 09:00 ~ 12:15	B10 # 13:45 ~ 18:30	B10 09:00 ~ 12:15	B10 13:45 ~ 17:00
13.5 デバイス/集積化技術		B13 13:45 ~ 17:00	B13 * 09:00 ~ 12:15	P6 13:30 ~ 15:30				
13.6 Semiconductor English Session			B7 10:30 ~ 11:30	P7 13:30 ~ 15:30				
13.7 ナノ構造・量子現象				P20 16:00 ~ 18:00		A26 15:45 ~ 17:45	A26 10:00 ~ 11:45	
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術			P6 09:30 ~ 11:30		B1 09:00 ~ 12:30		B1 09:00 ~ 12:30	B1 13:30 ~ 17:00
			B1 * 11:45 ~ 12:15					
13.9 光物性・発光デバイス	A35 09:00 ~ 11:45	A35 13:15 ~ 17:15	A35 09:00 ~ 11:45	A35 13:15 ~ 16:30		P10 13:30 ~ 15:30		
13.10 化合物太陽電池			A34 09:45 ~ 11:30	A34 13:00 ~ 15:30	A34 09:30 ~ 11:30	A34 13:00 ~ 18:00		
				P21 16:00 ~ 18:00				
15 結晶工学								
15.1 ノリク結晶成長				A25 # 13:15 ~ 19:00	P10 09:30 ~ 11:30			
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶		D61 13:15 ~ 15:30		P8 13:30 ~ 15:30				
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎					P11 09:30 ~ 11:30		B9 09:00 ~ 13:00	
15.4 III-V族窒化物結晶	A21 09:00 ~ 11:45	A21 * 13:15 ~ 18:00	A21 * 08:45 ~ 12:00		A21 09:00 ~ 12:00		A21 09:00 ~ 12:15	A21 13:15 ~ 15:30
							P5 09:30 ~ 11:30	
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶						P11 13:30 ~ 15:30	D61 09:00 ~ 11:45	D61 13:15 ~ 16:30
15.6 IV族系化合物 (SiC)				P9 13:30 ~ 15:30	C302 09:00 ~ 12:15	C302 * 13:45 ~ 19:00	C302 09:00 ~ 12:15	C302 13:45 ~ 16:15
15.7 エピタキシーの基礎								
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥					A23 09:00 ~ 11:45	A23 13:15 ~ 18:45	P6 09:30 ~ 11:30	
16 非晶質・微結晶 ※コードシェアセッションあり 9.4・16.2 (表の末尾参照)								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス						P12 13:30 ~ 15:30	A25 09:00 ~ 13:15	
16.2 エナジーハーベスティング								
16.3 シリコン系太陽電池			A24 09:00 ~ 11:30		A24 * 09:00 ~ 11:45	P13 13:30 ~ 15:30	A24 09:00 ~ 12:15	A24 13:15 ~ 16:15
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料					A25 09:30 ~ 11:45	A25 13:15 ~ 17:45		
17.2 グラフェン	A32 09:30 ~ 11:45	P5 13:30 ~ 15:30			A33 09:00 ~ 11:45	A33 13:15 ~ 18:15	A33 09:00 ~ 11:15	
17.3 層状物質							A32 * 09:00 ~ 11:45	
21 合同セッションK								
21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」				P10 13:30 ~ 15:30	A22 09:00 ~ 12:00	A22 13:30 ~ 18:00	A22 09:00 ~ 11:45	A22 12:45 ~ 14:15
22 合同セッションM								
22.1 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」			B12 09:00 ~ 12:00	B12 13:30 ~ 18:15	B12 09:30 ~ 12:15	P18 16:00 ~ 18:00		
CS コードシェアセッション								
3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバー			B3 09:30 ~ 12:15					
3.6 超高速・高強度レーザーと3.8 光計測技術・機器					C301 10:30 ~ 12:15	C32 * 13:45 ~ 18:00		
3.14 光制御デバイス・光ファイバーと3.15 シリコンフォトニクス						B8 13:30 ~ 17:30		
3.11 フォトニック構造・現象と13.7 ナノ構造・量子現象					B4 09:00 ~ 12:15	B4 13:45 ~ 15:45		
9.4 熱電変換と16.2 エナジーハーベスティング			A25 09:30 ~ 11:30	P22 16:00 ~ 18:00				
新規スピン操作方法および関連現象 (10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)、10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術、10.3 GMR・TMR・磁気記録技術、10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクスのコードシェアセッション)							C41 * 09:30 ~ 12:00	